

カスタムPtfеウェーハ洗浄バスケット 半導体シリコンウェーハホルダー 低バックグラウンドフッ素樹脂カセット

商品番号: PL-CP266



前書き

半導体プロセス向けの高純度カスタムPTFEウェーハ洗浄バスケット。低バックグラウンドトレース分析と強力な耐薬品性を考慮して設計されたこれら、特注のフッ素樹脂カセットは、重要なクリーンルーム環境や工業用研究所において、シリコンウェーハの溶出ゼロとコンタミネーションフリーの搬送を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

アプリケーション	説明	主なメリット
RCA洗浄 (SC-1/SC-2)	シリコン表面からの有機汚染物質、薄い酸化膜層、およびイオン性不純物の除去。	過酸化水素およびアンモニア水混合液に対する高い耐性。
フッ化水素酸エッチング	二酸化ケイ素層の選択的除去および表面不動態化。	HFに対する完全な耐性（石英やガラス製キャリアでは劣化してしまいます）。
ピラニアエッチング処理	硫酸と過酸化水素を使用した、重い有機残渣およびレジストの強力な除去。	高度な発熱および酸化環境下で構造的整合性を維持します。
フォトリソグラフィサポート	フォトレジスト材料の現像、剥離、およびリンス中のウェーハ搬送。	耐溶剤性により、剥離液にさらされてもキャリアが膨潤や軟化しません。
CMP後リンス	化学機械研磨 (CMP) に続く、研磨スラリーを除去するためのウェーハの重要な洗浄。	低パーティクル発生表面により、研磨工程後もウェーハが清浄に保たれます。
化合物半導体準備	先端オプトエレクトロニクス向けのGaAs、GaN、InPウェーハの専門的な洗浄。	優しく、精密なスロット加工されたサポートは、脆い化合物材料の損傷を防ぎます。
超音波/メガソニック洗浄	純水中でサブミクロンパーティクルを除去するための高周波振動洗浄。	材料特性は過度な振動を減衰させつつ、効果的なエネルギー伝達を可能にします。

パラメータカテゴリ	PL-CP266の仕様詳細
主材料	高純度PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) / PFA (ペルフルオロアルコキシ)
製造方法	高精度CNC加工 (特注製造)
対応ウェーハサイズ	完全カスタマイズ可能 (共通サイズ: 2"、3"、4"、6"、8"、12" または特注寸法)
スロット構成	プロセス要件に基づくカスタム間隔、深さ、および数量
ハンドル設計	固定式、着脱式、または一体化つり上げアイ (カスタマイズ可能)
耐薬品性	優秀 (すべての酸、アルカリ、および有機溶剤と互換性あり)
使用温度範囲	-200°C ~ +260°C (材料限界; アプリケーションに依存)
表面粗さ	パーティクルの捕捉を最小限に抑えるための制御されたCNC仕上げ
微量元素バックグラウンド	低レベルトレース分析用に最適化 (低バックグラウンド要件を満たす)

アプリケーション	説明	主なメリット
パラメータカテゴリ	PL-CP266の仕様詳細	
溶出プロファイル	ゼロ溶出 / 溶出性添加剤なし（溶出なし）	